

1700V高耐圧 SiC-MOSFET

SCT2H12NZ



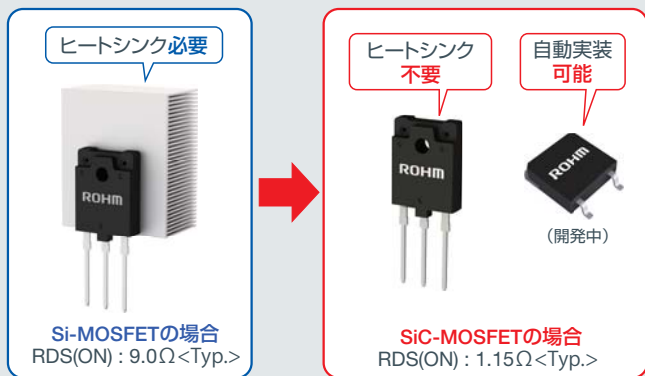
産業機器に搭載される補機電源に最適！ 1700V高耐圧SiC-MOSFET登場

製品概要

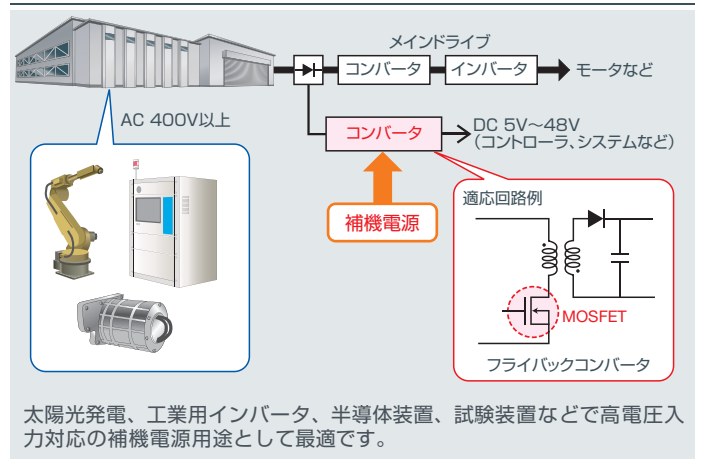
Siの限界を超えるデバイスとして注目のSiCデバイス。より高性能化のキー材料として大きく期待されています。高電圧・大電力の産業機器アイテムに搭載される補機電源ユニットには、従来1000V耐圧をこえるようなSi-MOSFETが採用されており、高効率SiC-MOSFETへ置き換えることで、発熱低減によるヒートシンクなど部品削減が期待できます。今回、新たに1700Vクラス製品をリリースし、SiC-MOSFETを容易に評価いただけるよう、評価用基板も準備しています。

■ SiC化でヒートシンク不要※

Siに比べSiCは大幅にオン抵抗が低いので、高効率に動作し発熱が低減できます。



■ 産機向け補機電源用に最適！



■ 挿入型と面実装型の2パッケージをラインアップさらに評価用電源基板も準備！

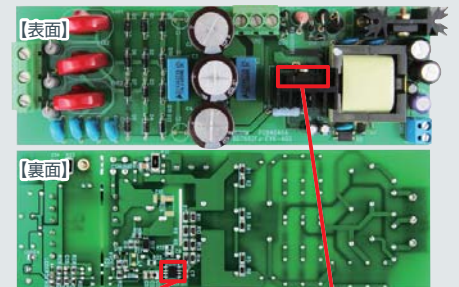
1700V SiC-MOSFETラインアップ

品名	パッケージ	極性	V _{DS}	I _b	P _b (T _C =25°C)	R _{DS(ON)} V _{GS} =18V	Q _g V _{GS} =18V
SCT2H12NZ	TO-3PFM	Nch	1700V	3.7A	35W	1.15Ω (Typ.)	14nC (Typ.)
☆SCT2H12NY	TO-268-2L			4A	44W		
☆SCT2750NY				5.9A	57W		

SiC-MOSFET評価用電源基板(入力：三相AC380V 出力：24V1A<24W>)も準備しています。
(ローム製SiC-MOSFET用AC / DCコンバータ制御IC BD7682FJ-LB搭載)

☆開発中

評価用基板 (BD7682FJ-LB-EVK-402)



本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または技術を輸出する場合、または国外に提供する場合には、同法に基づく許可が必要です。本資料の記載内容は2016年03月xx日現在のものです。